


	FQD12P10TM	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD12P10TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	1.FQD12P10TM.pdf 2.FQD12P10TM.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 45330 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQD12P10TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	45330 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 9.4A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 4.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	800pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD12P10TM ist neu im Original, Suche FQD12P10TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD12P10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD12P10TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD12P10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p>FQD12P10TM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p>FQD12P10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p>FQD13N06 FAIRCHI FQD13N06 FAIRCHI</p>
 <p>FQD12N20TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12N20TM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12P10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p>FQD13N06L FAIRCHI FQD13N06L FAIRCHI</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD10N20LTM	↔ FQD10N20TF	⇒ FQD10N20TF	D FQD10N20TM	⇒ FQD10N20TM
⊕ FQD11P06	⊗ FQD11P06-NL	D FQD11P06TF	⇒ FQD11P06TF	⇒ FQD11P06TM
⊗ FQD11P06TM	⊕ FQD12N10	⊗ FQD12N20	↔ FQD12N20L	⇒ FQD12N20LTF
D FQD12N20LTF	⊗ FQD12N20LTM	⊕ FQD12N20LTM	⊗ FQD12N20TF	⇒ FQD12N20TF
⇒ FQD12N20TM	↔ FQD12N20TM	⊗ FQD12P10	⊕ FQD12P10TF	⇒ FQD12P10TF
↔ FQD12P10TM	⇒ FQD13N06	D FQD13N06L	⊗ FQD13N06LTF	⊕ FQD13N06LTF
⊗ FQD13N06LTM	D FQD13N06LTM	⇒ FQD13N06LTM-NL	↔ FQD13N06TF	⇒ FQD13N06TF
⊕ FQD13N06TM	⊗ FQD13N06TM	↔ FQD13N10	⇒ FQD13N10L	⇒ FQD13N10LTF
⊗ FQD13N10LTF	⊕ FQD13N10LTM	⊗ FQD13N10LTM	D FQD13N10LTM-NL	⇒ FQD13N10TM
↔ FQD13N10TM	⊗ FQD13N20D	⊕ FQD14N15	⊗ FQD16N15	⇒ FQD16N25C

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited